

	<h2>SI3585CDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3585CDV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 3.9A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3585CDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 64238 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3585CDV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 3.9A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	64238 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W, 1.3W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.9A, 2.1A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	58 mOhm @ 2.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.8nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3585CDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3585CDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3585CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3585CDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3585CDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 3.9A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3585CDV-T1-E3</b> VISHAY VISHAY TSOP-6</p>	 <p><b>SI3585CDV</b> VISHAY SI3585CDV VISHAY</p>	 <p><b>SI3552DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3554DV-T1-E3</b> Vishay Precision Group SI3554DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3552DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3585DV</b> VISHAY SI3585DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3585DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 2A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3.	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3493DV-T1-GE3
 SI3495DV	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3495DV-T1-GE3
 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3500-A-GM
 SI3529DV-T1-GE3	 SI3529DV-T1-GE3	 SI3552DV	 SI3552DV-T1	 SI3552DV-T1-E3
 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3585CDV	 SI3585CDV-T1-GE3
 SI3585DV	 SI3585DV-T1	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-GE3
 SI3585DV-T1-GE3	 SI3586DS-TI-E3	 SI3586DV	 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-E3
 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-E3
 SI3588DV-T1-GE3	 SI3588DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3590DV-T1-GE3	 SI3801DV-T1
 SI3803DV-T1	 SI3805DV-T1	 SI3805DV-T1-E3	 SI3805DV-T1-E3	 SI3812DV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited